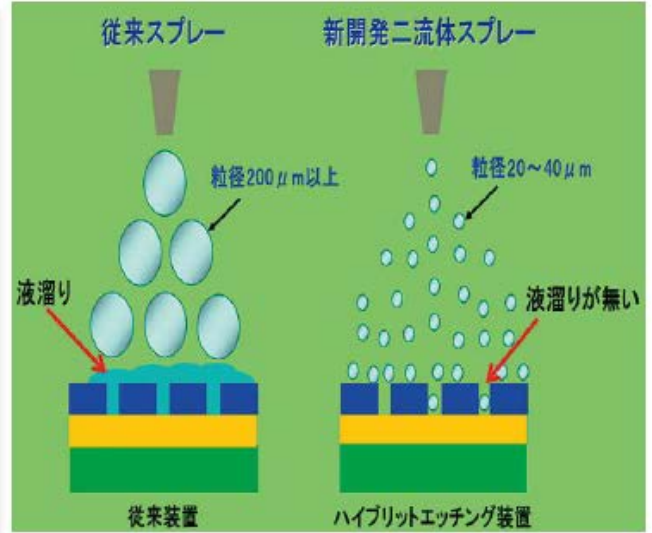
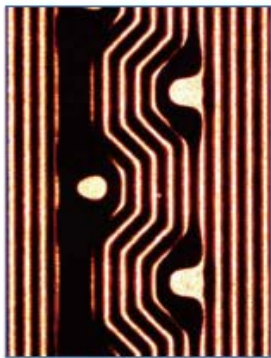


ハイブリッドエッチング装置

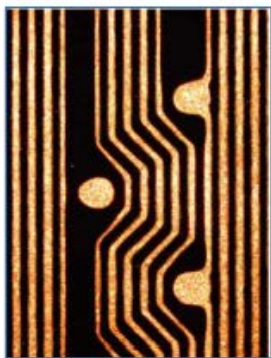
(特許取得済)



回路表面

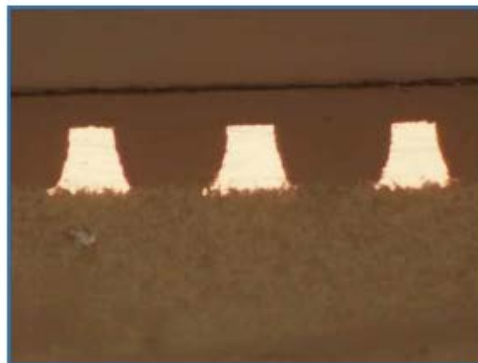


エミネントタイプ



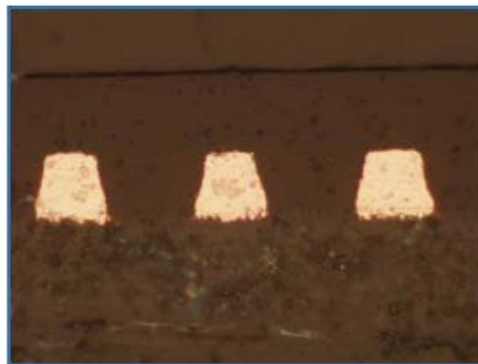
ハイブリッドエッチング

回路断面



L/S=15/15 μ m

Top	9.7 μ m
Bottom	16.7 μ m
Thickness	12.4 μ m
E F	3.5



L/S=15/15 μ m

Top	9.4 μ m
Bottom	14.5 μ m
Thickness	12.5 μ m
E F	4.9